

2SB502A/503A

シリコンPNP三重拡散メサ形トランジスタ

通信工業用

単位: mm

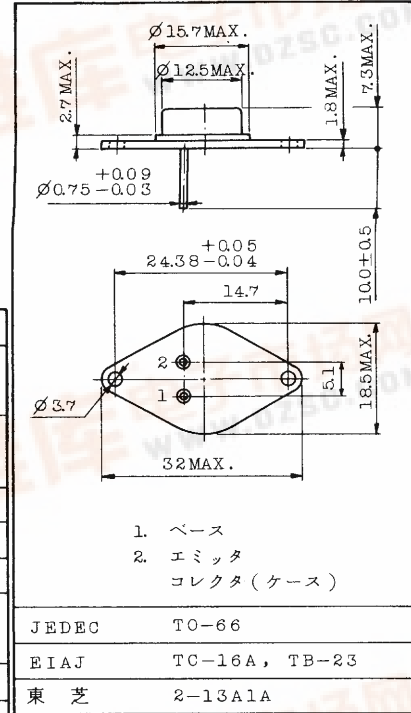
- 低周波電力増幅用
- 定電圧電源用

特長

- ・ コレクタ損失が25W得られます。: $P_C=25W$ ($T_c=25^\circ C$)
- ・ 飽和電圧が低い。: $V_{CE(sat)}=-1.5V$ (最大) ($I_C=-3A$)
- ・ エミッタ耐圧が高い。: $V_{EBO}=-10V$
- ・ 2SD877とコンプリメンタリになります。

最大定格 ($T_a=25^\circ C$)

項 目	記 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	2SB502A	-110	V
	2SB503A	-80	
コレクタ・エミッタ間電圧	2SB502A	-80	V
	2SB503A	-50	
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-10	V
コレクタ電流	I_C	-3	A
ベース電流	I_B	-1	A
コレクタ損失	P_C	$T_a=25^\circ C$	1.5
		$T_c=25^\circ C$	25
接合温度	T_j	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-65~150	$^\circ C$



アクセサリはAC74を適用

電気的特性 ($T_a=25^\circ C$)

項 目	記 号	測 定 条 件	最 小	標 準	最 大	単 位			
コレクタシャ断電流	2SB502A	$V_{CB}=-110V, I_E=0$	-	-	-100	μA			
	2SB503A						$V_{CB}=-80V, I_E=0$		
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=-10V, I_C=0$	-	-	-100	μA			
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	2SB502A	$I_C=-100mA, I_B=0$	-	-	-	V			
	2SB503A						$V_{(BR)CEO}$		
直 流 電 流 増 幅 率	$h_{FE(1)}$ (注)	$V_{CE}=-5V, I_C=-0.5A$	30	80	280				
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=-5V, I_C=-2.5A$	15	25	-				
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-3A, I_B=-0.3A$	-	-	-1.5	V			
ベース・エミッタ間飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C=-3A, I_B=-0.3A$	-	-	-1.8	V			
トランジション周波数	f_T	$V_{CB}=-10V, I_C=-0.5A$	-	5	-	MHz			
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=-10V, I_E=0, f=1MHz$	-	200	-	pF			
スイッチング時間	ターンオン時間	t_{on}				-	1.0	-	μs
	蓄積時間	t_{stg}	-	3.0	-				
	下降時間	t_f	繰り返し周期 $\leq 1\%$	-	1.0	-			

注: $h_{FE(1)}$ 分類 R: 30~70, O: 50~140, Y: 100~280